

## 产品介绍

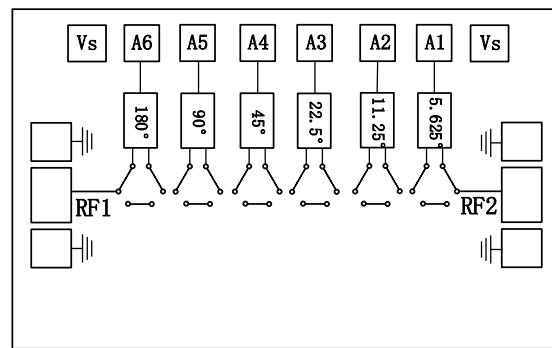
YPS32-0815A1 是一款性能优良的 GaAs 六位数控移相器芯片，频率范围覆盖 8~15GHz，插入损耗为 8.5dB，基本移相位为 5.625°、11.25°、22.5°、45°、90°、180°，总移相量为 354.375°，移相精度为 2.5°。

该芯片采用 0/+5V 控制，采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

## 关键技术指标

- 频率范围: 8-15GHz
- 插入损耗: 8.5dB
- 移相精度: 2.5°
- 输入回波损耗: 18dB
- 输出回波损耗: 15dB
- 芯片尺寸: 2.60mm × 1.40mm × 0.10mm

## 功能框图



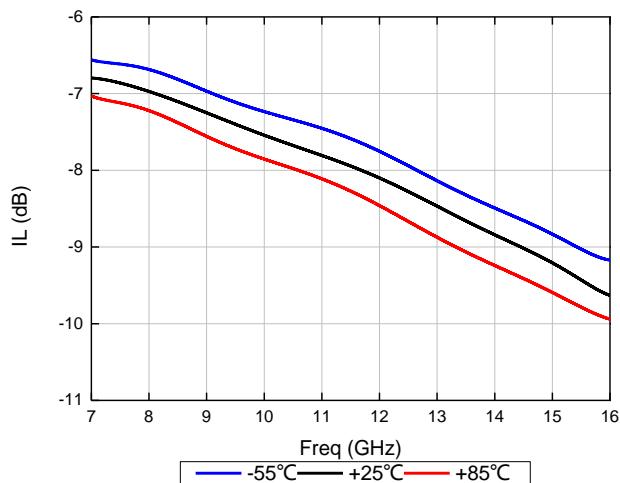
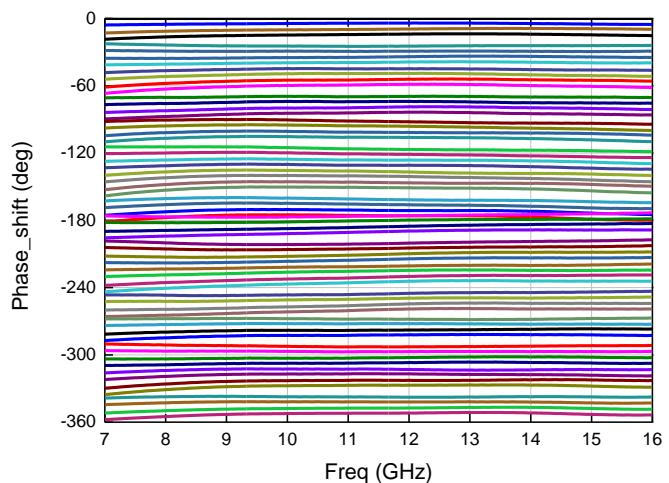
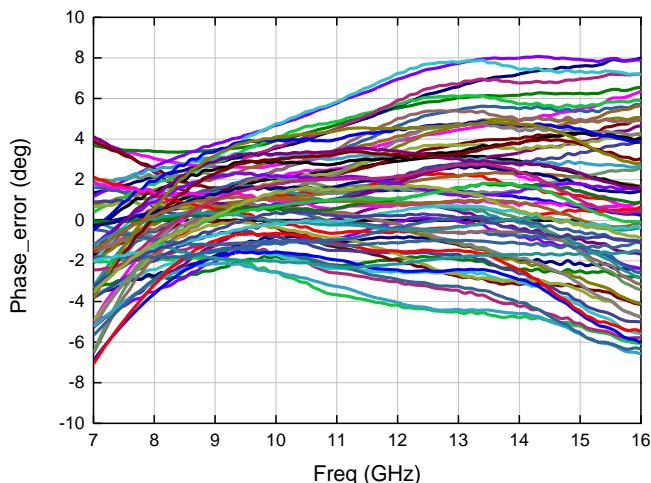
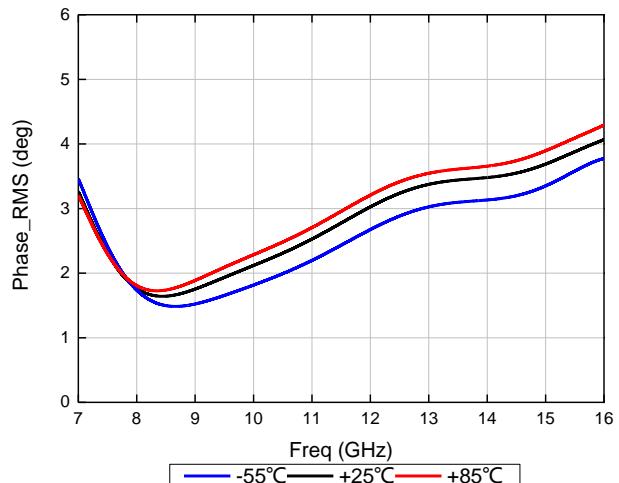
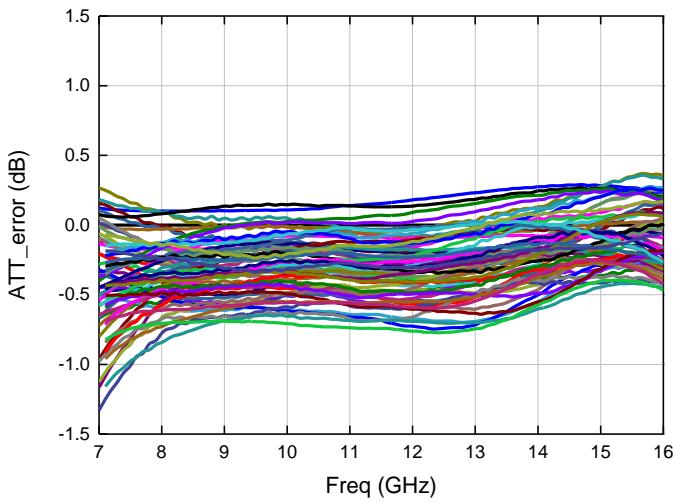
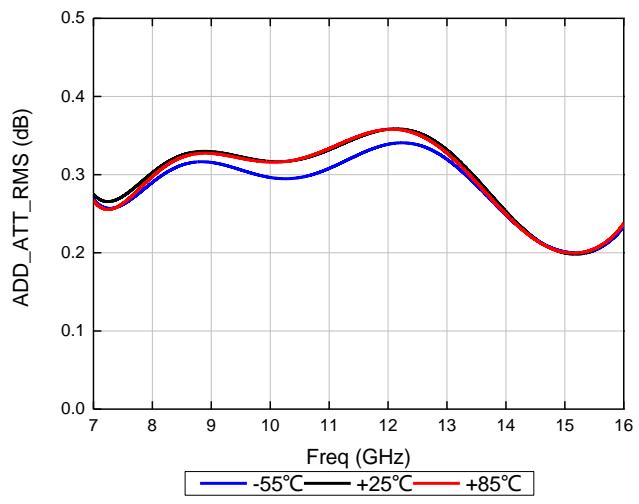
## 电性能表 (T<sub>A</sub>=+25°C, V<sub>SS</sub>=-5V)

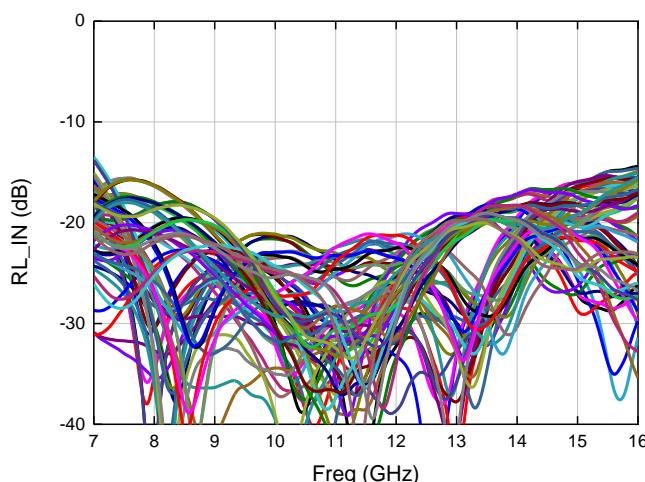
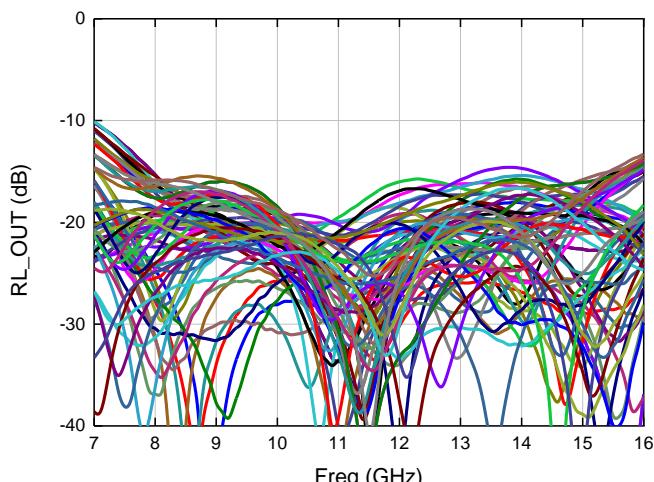
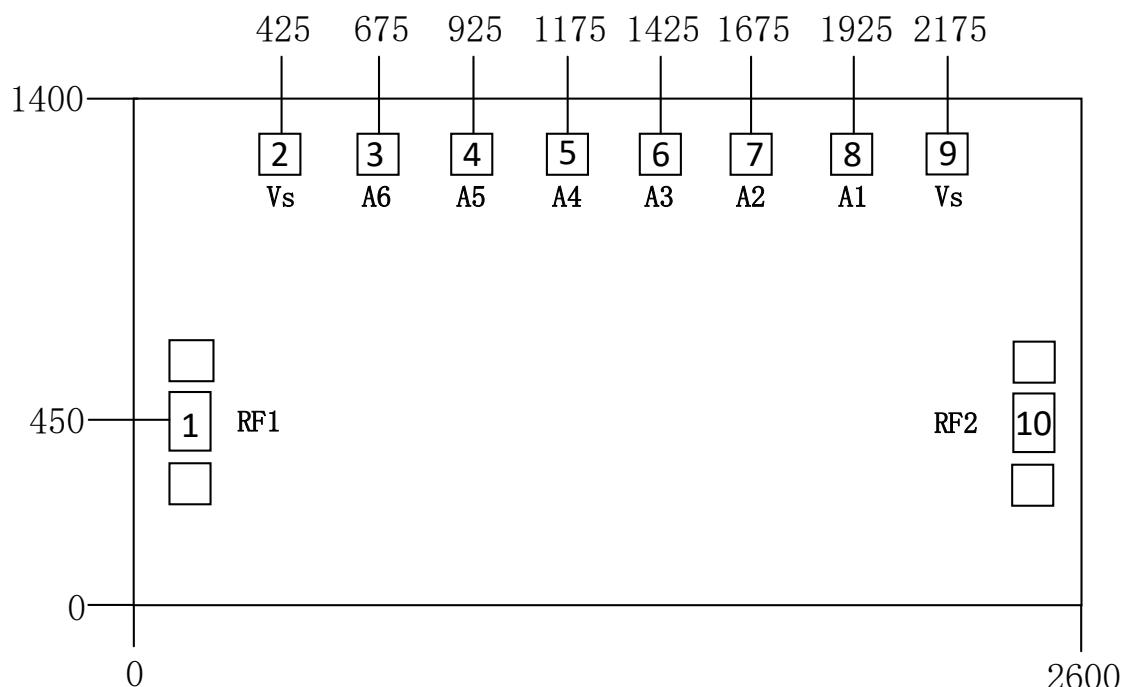
参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	8	—	15	GHz
插入损耗	IL	—	8.5	9.5	dB
移相误差	Phase_error	-6	—	+8	°
移相精度	Phase_RMS	—	2.5	3.5	°
移相附加衰减	ATT_error	-0.8	—	+0.3	dB
附加衰减精度	ADD_ATT_RMS	—	0.25	0.35	dB
输入1dB压缩功率	IP1dB	—	26	—	dBm
开关时间	T	—	—	40	ns
输入回波损耗	RL_IN	—	18	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	—	15	—	dB
工作电流	Iss	—	6	—	mA
工作电压	V <sub>SS</sub>	-5	—	-6	V
控制电压	V <sub>C</sub>	0/+3.3或0/+5			V

## 使用限制参数

控制电压范围	0 ~ +6V
最大输入功率	+30dBm
贮存温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C ~ +125°C

测试曲线 ( $T_A=+25^\circ\text{C}$ ,  $V_{SS}=-5\text{V}$ )

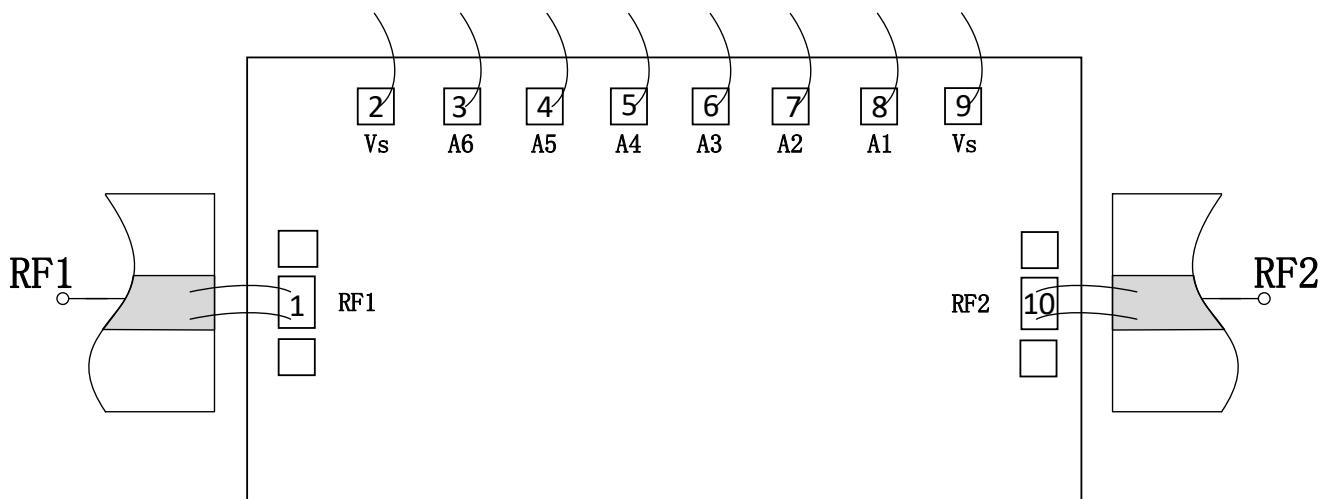
**插入损耗**

**移相量**

**移相误差**

**移相精度**

**移相附加衰减**

**附加衰减精度**


**输入回波损耗**

**输出回波损耗**

**芯片端口图 (单位:  $\mu\text{m}$ )**

**端口定义**

序号	端口名	定义	信号或电压
2、9	Vs	电源负电	-5V
3-8	A1-A6	控制信号	0/+3.3V 或 0/+5V
1	RF1	移相器射频输入	RF
10	RF2	移相器射频输出	RF

**真值表**

移相状态	5.625°	11.25°	22.5°	45°	90°	180°
	A1	A2	A3	A4	A5	A6
基态	0	0	0	0	0	0
5.625°	1	0	0	0	0	0
11.25°	0	1	0	0	0	0
22.5°	0	0	1	0	0	0
45°	0	0	0	1	0	0
90°	0	0	0	0	1	0
180°	0	0	0	0	0	1

**建议装配图**

**注意事项**

- 1) 在净化环境装配使用;
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径  $25\mu\text{m}$  金丝），键合线长度为  $400\mu\text{m}$  左右；
- 4) 烧结温度不要超过  $300^\circ\text{C}$ ，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。